

Porta Wafer Da 6 Pollici In Ptfе Per Pulizia A Umido, Resistente Ad Acidi E Alcali Per Incisione, Vettore Wafer In Fluoropolimero

Numero articolo: PL-CP421



introduzione

Porta wafer da pulizia ad alta purezza da 6 pollici in PTFE, progettati per processi di incisione a umido aggressivi. Questi vettori in fluoropolimero resistenti agli acidi offrono eccezionale stabilità chimica e contaminazione ultra-bassa per la produzione di semiconduttori e applicazioni di analisi di tracce di laboratorio impegnative e lavorazioni chimiche.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Incisione a Umido dei Semiconduttori	Lavorazione di wafer di silicio in bagni di HF, BOE o acido fosforico caldo.	Previene la contaminazione metallica e resiste a chimiche aggressive.
Fabbricazione di Celle Solari	Pulizia e strutturizzazione di substrati di silicio per la produzione di celle fotovoltaiche.	Durabilità per grandi volumi e resistenza alle soluzioni di strutturazione caustiche.
Analisi di Metalli in Tracce	Pulizia di vetreria di laboratorio e substrati prima dell'analisi ICP-MS.	Livelli di fondo ultra-bassi e nessun rilascio ionico per dati precisi.
Produzione di MEMS	Movimentazione di sistemi micro-elettromeccanici durante l'incisione ionica reattiva profonda o il rilascio a umido.	Movimentazione delicata con alta precisione dimensionale per strutture fragili.
Deposizione Chimica da Vapore	Pre-pulizia dei substrati per garantire una crescita di film sottile di alta qualità.	Garantisce una superficie atomica pulita resistendo agli acidi di pretrattamento.
Pulizia Farmaceutica	Sterilizzazione e pulizia di componenti ad alta purezza nella R&S farmaceutica.	Materiale conforme FDA con eccellente resistenza agli agenti di sterilizzazione.
Processi di Galvanica	Tenuta dei substrati durante la deposizione precisa di metalli in bagni acidi o alcalini.	Isolamento elettrico e completa resistenza agli elettroliti di placcatura.

Categoria Specifica	Dettagli per PL-CP421
Numero di Modello	PL-CP421
Materiale di Base	PTFE Vergine ad Alta Purezza (PFA/TFM disponibili su richiesta)
Diametro Wafer Primario	6 pollici (150 mm) standard
Capacità Wafer	Completamente Personalizzabile (es. 25 fessure, 50 fessure, o conteggi su misura)
Larghezza/Passo Fessura	Personalizzabile in base allo spessore del substrato e ai requisiti di spaziatura
Design della Maniglia	Fissa, Staccabile o Estesa (Personalizzata per la profondità del bagno)
Resistenza alla Temperatura	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Metodo di Fabbricazione	Lavorazione CNC di Precisione a 5 Assi
Finitura Superficiale	Ra < 0,8 µm (Tipico) o lucidatura personalizzata
Compatibilità Chimica	Universale (Eccetto metalli alcalini fusi e fluoro elementare)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Categoria Specifica	Dettagli per PL-CP421	
Conformità	Grado Semiconduttore / Grado Analisi di Tracce	